DOI: 10.15541/jim20140060

文章编号: 1000-324X(2014)10-1067-06

紫外光激发 Ce3+掺 YVO4 蓝光发射性能研究

张守超¹, 阮永丰², 贾国治¹, 冯志辉¹, 刘枝朋¹, 裴利斌¹ (1. 天津城建大学 理学院, 天津 300384; 2. 天津大学 理学院, 天津 300072)

摘 要: 利用提拉法生长了 YVO₄ 和掺 2.0at% CeO₂(或 Ce₂(CO₃)₃)的 YVO₄: Ce³⁺晶体。样品的 XRD 测试表明 Ce³⁺代替 Y³⁺进入晶格,Ce³⁺的加入并没有影响 YVO₄ 的晶格结构。XPS 测试显示 YVO₄: Ce³⁺晶体中 Ce 离子 3d 分裂为 882.0、885.8、902.9、908.0 和 915.9 eV 等 5 个峰,峰位表明样品中铈离子是以 Ce³⁺和 Ce⁴⁺两种价态形式存在。YVO₄ 和 YVO₄: Ce³⁺激发谱都呈现出 260~360 nm 宽带激发,此激发带源于基质中 VO₄³⁻离子团的配体 O 到 V 的电荷迁移 吸收。使用 325 nm 的紫外线激发时,两种样品均可发出以 440 nm 为中心的宽带蓝光,其中 YVO₄ 发射峰应归属于 VO₄³⁻离子团中 $^{3}T_{2} \rightarrow ^{1}A_{1}$ 和 $^{3}T_{1} \rightarrow ^{1}A_{1}$ 跃迁;而 YVO₄: Ce³⁺的蓝光发射则来源于 Ce³⁺的 5d→4f 的跃迁。分析可知 YVO₄: Ce³⁺中 VO₄³⁻的 π 轨道和 Ce³⁺的电子波函数能有效地重叠,使得 VO₄³⁻和 Ce³⁺可通过交换作用有效地向 Ce³⁺传递能量,可大幅提高 Ce³⁺的蓝光发射强度。实验结果显示 YVO₄: Ce³⁺可作为 UV-LED 管芯激发的白光发光二极管用高亮度蓝色发光材料。

关 键 词: YVO₄:Ce³⁺; 蓝光发射; 紫外激发; 能量传递; 白光 LED

中图分类号: TQ174 文献标识码: A

Blue-emitting Properties of Ce³⁺ Doped YVO₄ under Ultraviolet Excitation

ZHANG Shou-Chao¹, RUAN Yong-Feng², JIA Guo-Zhi¹, FENG Zhi-Hui¹, LIU Zhi-Peng¹, PEI Li-Bin¹ (1. School of Science, Tianjin Chengjian University, Tianjin 300384, China; 2. School of Science, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract: YVO₄ and YVO₄:Ce³⁺ single crystals doped with 2.0at% CeO₂ (or Ce₂(CO₃)₃) were grown by using the Czochralski method. XRD pattern shows that Ce³⁺ ion enters the YVO₄ lattice by occupying the Y³⁺ sites and the YVO₄ crystal structure change little by the addition of Ce ions. The X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) shows that the Ce (3d) peak splits into five peaks located at 882.0, 885.8, 902.9, 908.0 and 915.9 eV, which indicates that the Ce³⁺ and Ce⁴⁺ ions coexist in both kind of samples. The excitation spectra of YVO₄ and YVO₄:Ce³⁺ crystals are both in the range from 260 nm to 360 nm, due to the charge transfer transition of the O²⁻-V⁵⁺ ion pairs of VO₄³⁻ polyhedron. YVO₄ and YVO₄:Ce³⁺ single crystals radiate a wideband blue light centered at 440 nm when excited by 325 nm ultraviolet light, the former corresponds to ${}^3T_2 \rightarrow {}^1A_1$ and ${}^3T_1 \rightarrow {}^1A_1$ transition of VO₄³⁻, while the latter corresponds to 5d→4f transition of Ce³⁺. In YVO₄: Ce³⁺ crystal, the wave functions of Ce³⁺ overlaps effectively to the π orbital of VO₄³⁻, via this interaction the energy can be transfer effectively from VO₄³⁻ to Ce³⁺ crystal is a potential blue-emitting intensity of Ce³⁺ is improved significantly. Experimental results show that YVO₄: Ce³⁺ crystal is a potential blue-emitting material for white-emitting LED under ultraviolet excitation.

Key words: YVO₄: Ce³⁺; blue-emitting; ultraviolet excitation; energy transfer; white LED

收稿日期: 2014-02-10; 收到修改稿日期: 2014-03-23

基金项目: 国家自然科学基金(11247025); 天津市自然科学基金(11JCYBJC05200)

National Natural Science Foundation of China(11247025); Natural Science Foundation of Tianjin(11JCYBJC05200)

作者简介: 张守超(1982-), 男, 博士, 副教授. E-mail: doisyes@163.com

白光 LED 相对于传统的白炽灯、荧光灯具有节能、环保和长寿命等优点,因而得到大力发展,正逐步取代白炽灯和荧光灯成为常态照明光源^[1-3]。目前白光 LED 的实现方式主要有光转换型、芯片组合型、多量子阱型和量子点型等。基于工艺性、成本、技术现状等因素考虑,光转换型 LED 是目前白光照明的发展主流。实现白光转换的关键技术之一就是合成高效光转换材料。因此,与白光 LED 相匹配的光转换材料成为研究的重点。

目前商业上主要采用氮化物 LED 芯片激发黄 色荧光粉 Y₃Al₅O₁₂: Ce³⁺(YAG:Ce³⁺)的方法来获得 白光, 但由于这种方法只有蓝、黄两种色光调和, 所 得白光缺少红色成分, 显色指数低, 色温偏高[4]; 此外, 此种荧光粉的颜色输出对温度和电流的依赖 性强, 制约其向大功率 LED 方向发展。随着紫外-近紫外发射的 InGaN 管芯(UV-LED)技术的不断成 熟, 使用"UV-LED+三基色荧光粉"模式实现白光 发射成为人们的研究重点。BaMgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺(BAM: Eu²⁺) 作为荧光灯用蓝色荧光粉,现已在白光 LED 中获得商业化应用。但是铝酸盐体系在涂屏焙烧时 热劣化严重并且 Eu2+不稳定, 在 UV 辐照和放电离 子的长期轰击下, 易变成 Eu3+, 从而使其发光性能 下降^[5-8]。 寻求可以有效吸收紫外光且性能稳定的无 机荧光体以及稳定的激活离子是解决这一问题的重 要方向。Riwotzki 等^[9]研究发现 YVO4中 VO4³⁻在紫 外区有强烈吸收。Osawa 等[10]发现紫外光激发下 VO_4^3 的发射带如果与稀土离子的能级重合, 能量则 可以有效地由 VO43-传递给稀土离子。Blasse 的键角 理论说明紫外光激发钒酸盐荧光体能量传递的效率 由一个交换过程以及 V-O-Re3+之间的键角所控制[11]。

基于 YVO₄ 具有有效的基质敏化带,紫外及近紫外区域吸收截面大、吸收效率高及稳定性良好等优点,国内外科研工作者分别以 YVO₄ 为基质,合成了 YVO₄: Eu³⁺、YVO₄: Dy³⁺、YVO₄: Tm³⁺等新型荧光材料^[12-18],其中以研究 YVO₄: Eu³⁺红光发射居多。Ce³⁺电子能级结构简单,掺杂进入晶格格位后受晶体场影响,激发态 5d 能态发生劈裂成为能带。因此,Ce³⁺本身具有强而宽的 4f-5d 吸收带,它可有效地吸收激发能量或者来自于基质敏化的能量。受5d 能态扩展的径向波函数的影响,Ce³⁺的发射谱通常具有较大的斯托克斯位移,随着掺杂基质的不同,其发射范围可从紫外区域延至红光发射区。通过掺杂不同的基质材料,可以实现不同波长的光谱发射。Ce³⁺掺杂的多种化合物都可实现蓝光发射,包括 Y₅Si₃O₁₂N: Ce³⁺、Ba₂Ln(BO₃)₂Cl (Ln=Gd, Y): Ce³⁺、

CaLaGa₃S₆O: Ce³⁺、Ca₃Si₂O₇:Ce^{3+[19-23]}等。本工作选择 YVO₄ 作为 Ce³⁺掺杂基质,利用提拉法生长了YVO₄和 YVO₄: Ce³⁺晶体。基于 YVO₄对 Ce³⁺的基质敏化特性,通过 X 射线、吸收谱、X 射线光电子能谱(XPS)、荧光光谱等手段对样品的晶体结构及其光学性质进行了表征。

1 实验方法

1.1 晶体生长

采用中频感应单晶炉和提拉法沿c轴方向生长了高质量的YVO₄和YVO₄:Ce³⁺晶体。Ce³⁺进入YVO₄采用两种不同的掺杂方式,即分别掺入了CeO₂和Ce₂(CO₃)₃,掺杂浓度均为2.0at%。生长YVO₄和YVO₄:Ce³⁺的化学反应方程式如下:

$$Y_2O_3+V_2O_5=2YVO_4$$

$$2x\text{CeO}_2 + (1-x)\text{Y}_2\text{O}_3 + \text{V}_2\text{O}_5 = 2\text{Y}_{1-x}\text{Ce}_x\text{VO}_4 + \frac{4+x}{2}\text{O}_2$$

xCe₂(CO₃)₃+(1-x)Y₂O₃+V₂O₅=2Y_{1-x}Ce_xVO₄+3xCO₂ 晶体生长过程可参考文献[24], 生长的晶体如图 1 所示。

1.2 样品的加工测试

将样品 $a(YVO_4)$ 、b($\ CeO_2$ 的 $\ YVO_4$: $\ Ce^3$)和 $\ c$ (掺 $\ Ce_2(CO_3)_3$ 的 $\ YVO_4$: $\ Ce^{3+}$,下同)分别垂直于 $\ c$ 轴 切割,制成 1 mm 厚的晶片并抛光。用日本理学 $\ D/MAX-2500$ 型 $\ X$ 射线衍射仪($\ Cu$ 靶, $\ K\alpha$ 射线 $\ \lambda=0.154056$ nm,管电压 $\ 40\ kV$,管电流 $\ 100\ mA$)分析样品的物相结构。用 $\ Simidazu$ 公司的 $\ UV-3101$ 分光光度计进行样品吸收光谱的测量,测量的波长范围为 $\ 190~800$ nm。采用美国 PE 公司的 $\ PHI1600$ 型 $\ X$ 射线光电子能谱仪测试样品的 $\ X$ 射线光电子谱($\ XPS$)。

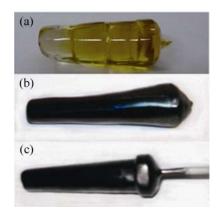


图 1 YVO₄和 YVO₄: Ce^{3+} 晶体 Fig. 1 YVO₄ and YVO₄: Ce^{3+} crystals (a) YVO₄; (b) YVO₄: Ce^{3+} doped with CeO_2 ; (c) YVO₄: Ce^{3+} doped with CeO_2 (CO₃)₃

使用 Horiba Jobin Yvon 公司的 Fluorolog3-21 型荧光光谱仪(Xe 灯,功率 450 W)测量样品的发射光谱和激发光谱。在 He-Cd 激光器 325 nm 激光激发下观察了样品的蓝光发射。以上测试均在室温下进行。

2 结果与讨论

2.1 晶体 XRD 测试

图 2(a)是 YVO4 晶体粉末的 XRD 图谱, 图 2(b)、 (c)是分别掺入 CeO₂和 Ce₂(CO₃)₃的 YVO₄: Ce³⁺晶体 粉末的 XRD 图谱。三者的衍射峰与 JCPDF 卡片 17-0341 符合得很好。由图 2 可见, 三者均为单一的 YVO₄ 物相, 掺杂后样品的各个衍射峰的位置基本 没有变化, 说明掺杂并没有改变晶体的结构, 但衍 射峰的强度相对于 YVO4有所降低。离子半径对置 换型固熔液的生成有很大影响。当被取代离子的半 径 r_1 与取代离子的半径 r_2 满足 $(r_1 - r_2)/r_1 < 15%$ 时,容 易被取代; 当 $(r_1-r_2)/r_1 < 30\%$ 时很难被取代^[25]。Ce³⁺ 的半径(~0.102 nm)和 Y3+的半径(~0.089 nm)相近, 满足 $(r_1 - r_2)/r_1 = 14.6\% < 15\%$, Ce³⁺容易取代 Y³⁺ 进入基质晶格。掺入少量的 Ce3+并不会改变晶体的 结构, 由于Ce3+半径略大于Y3+半径, 掺杂引起了晶 体的晶胞参数增大(如表 1 所示), 这与辛娟等研究 Eu3+掺杂 YVO4情况类似[26]。掺杂导致晶格缺陷产 生,这在一定程度上降低了衍射峰的强度。

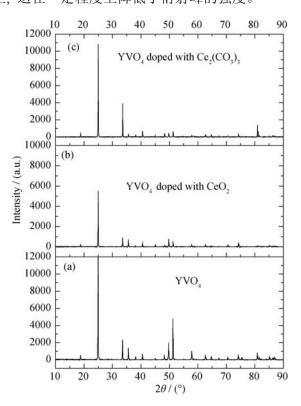


图 2 YVO₄和 YVO₄: Ce³⁺晶体的 XRD 图谱 Fig. 2 XRD patterns of YVO₄ and YVO₄: Ce³⁺ crystals

Table 1 Variety of cell parameters of YVO₄:Ce³⁺ crystals doped with CeO₂ and Ce₂(CO₃)₃

Samples -	Cell parameter/nm		Cell volume/nm ³
	a=b	С	$V=a^2c$
YVO ₄	0.712140	0.629113	0.319050
Doped with CeO ₂	0.712257	0.630066	0.319639
Doped with Ce ₂ (CO ₃) ₃	0.712641	0.630389	0.320148

2.2 晶体吸收光谱

图 3 所示为 YVO₄和 YVO₄: Ce^{3+} 晶体的吸收光谱。图 3(a)所示为 YVO₄ 晶体吸收光谱。在可见光区域,整条谱线光滑均匀,没有明显的吸收峰或吸收带。图 3(b)和(c)分别为掺杂 CeO_2 和 $Ce_2(CO_3)_3$ 的 YVO₄: Ce^{3+} 晶体的吸收光谱,吸收谱呈现出宽带吸收的特征,这与 Ce^{3+} 特有的宽吸收带性质是一致的。较宽的吸收带覆盖了整个可见光区域,在 465 nm 处的吸收峰对应 Ce^{3+} 的 $^2F_{5/2} \rightarrow ^2D_{3/2}$ 跃迁。掺 $Ce_2(CO_3)_3$ 的 YVO₄: Ce^{3+} 晶体在 465 nm 附近的吸收更强一些,这是由于掺 $Ce_2(CO_3)_3$ 的 YVO₄: Ce^{3+} 晶体中 Ce^{3+} 的浓度更大一些,相应的 $^2F_{5/2} \rightarrow ^2D_{3/2}$ 吸收更强一些。YVO₄和 YVO₄: Ce^{3+} 在 350 nm 以下表现为强烈吸收,这是源于 VO_4 3 的本征吸收。

2.3 XPS 性能测试

为了分析晶体中 Ce 的价态,对掺 $Ce_2(CO_3)_3$ 和 CeO_2 的 YVO_4 : Ce^{3+} 晶体切片分别进行了 XPS 测试,测试结果如图 4 所示。图 4 中 5 个 XPS 峰清晰可辨,它们的位置从小到大依次为 882.0、885.8、902.9、908.0、915.9 eV。根据标准数据(PHI5300ESCA)和文献报道^[27]Ce⁴⁺的特征峰应位于 882.0、908.0、915.9 eV,表现为 3 个特征峰位,其中 915.9 eV 是 Ce^{4+} 存在的"卫星峰"。 Ce^{3+} 特征峰在 885.8、902.9 eV,表现为两个特征峰位。综上所述,两种样品中的 Ce^{3+}

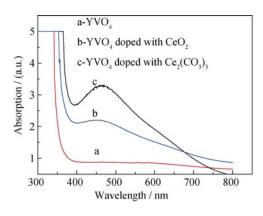


图 3 YVO₄和 YVO₄: Ce³⁺晶体的吸收光谱图 Fig. 3 Absorption spectra of YVO₄ and YVO₄: Ce³⁺ crystals

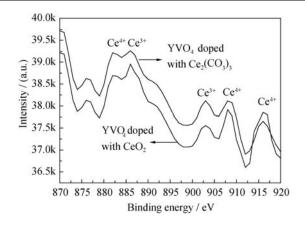


图 4 YVO₄: Ce³⁺晶体切片的 XPS 谱图 Fig. 4 XPS spectra of YVO₄: Ce³⁺ crystal plate

离子均以 Ce^{3+} 、 Ce^{4+} 两种不同价态形式共存。通过对各个峰值曲线拟合,利用 Ce^{3+} 和 Ce^{4+} 拟合后的面积计算得出了两种样品中二者的相对含量。掺 $Ce_2(CO_3)_3$ 的样品中 Ce^{3+} 相对含量为 78.5%, Ce^{4+} 相对含量为 21.5%; 掺 CeO_2 的样品中 Ce^{3+} 相对含量为 66.7%, Ce^{4+} 相对含量为 33.3%。由于晶片在抛光过程中表面的 Ce^{3+} 可能受热部分被氧化,上述方法得到的 Ce^{3+} 的相对含量可能比晶体中 Ce^{3+} 的实际含量要低。

2.4 晶体的激发和发射光谱

图 5 为发射波长(λ_{em})为 440 nm, YVO₄和 YVO₄: Ce³⁺晶体的激发光谱,两者都呈现宽带激发,激发带宽 260~360 nm, 对应 VO₄³⁻中的 O²⁻到中心离子 V⁵⁺的电荷迁移跃迁吸收。YVO₄: Ce³⁺的激发谱中包含中心波长为 325 nm 激发峰,峰值位于紫外光区域,根据 Ce³⁺离子的能级归属^[28],对应于 Ce³⁺从基态到 2 D_{5/2} 态的激发。相比于 YVO₄, YVO₄: Ce³⁺的激发谱的带宽和强度都有所改变。样品 c 的激发谱强度比样品 b 的略大,说明在掺 Ce₂(CO₃)₃ 的样品中 Ce³⁺浓度要高一些,这与 XPS 测试结果是一致的。对于蓝光发射来说,两种样品均以 325 nm 为最佳激发波长,并且掺入 Ce₂(CO₃)₃ 的 YVO₄: Ce³⁺晶体具有更强的激发效果。可以利用这个吸收带来激发 YVO₄: Ce³⁺中铈离子的 4f-5d 的跃迁,得到性能优良的蓝光发射。

图 6 为在 325 nm 紫外光激发下, YVO₄和 YVO₄: Ce³⁺的发射光谱以及在 He-Cd 激光器 325 nm 单色光激发下样品的发光图样。三个样品的发射谱都呈现出良好的蓝光发射, YVO₄的发射谱在 350~650 nm 的范围内有一个宽带发射峰,发射主峰位置在 435 nm 附近,发射光谱呈现不对称性的结构,这表明它并不是由单一的辐射跃迁造成的,应归属于 VO_4^{3-} 离子团中 $^3T_2 \rightarrow ^1A_1$ 和 $^3T_1 \rightarrow ^1A_1$ 跃迁。由于 3T_2

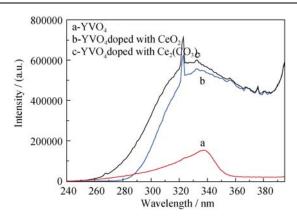


图 5 YVO₄和 YVO₄: Ce³⁺晶体的激发光谱,发射波长为 440 nm Fig. 5 Excitation spectra of YVO₄ and YVO₄: Ce³⁺ under λ_{em} of 440 nm

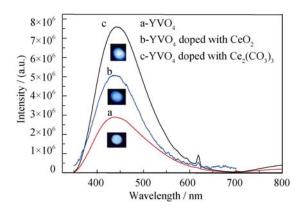


图 6 YVO₄和 YVO₄: Ce³⁺晶体的发射光谱(λ_{ex} =325 nm) 及 325 nm 激光激发下样品的蓝光发射

Fig. 6 Emission spectra under λ_{ex} of 325 nm and the blue emitting under the excitation of 325 nm laser of YVO₄ and YVO₄: Ce³⁺

和 $^{3}T_{1}$ 之间的能量差值很小(约为 500 cm $^{-1}$), 所以这两个能级返回基态 $^{1}A_{1}$ 产生的跃迁能量也非常相近,相应所产生的辐射波相互重叠部分就非常大,一般很难分辨出来。

掺杂 CeO_2 和 $Ce_2(CO_3)_3$ 的 YVO_4 : Ce^{3+} 的发射光 谱如图 6 中曲线 b 和 c 所示,相比于 YVO_4 蓝光发 射更加明亮清晰。发射主峰的位置分别在 438 nm 和 442 nm 附近, 对两个发射光谱进行 Gauss 拟合,如图 7 所示。拟合的曲线中掺 CeO_2 的 YVO_4 : Ce^{3+} 发射谱的两个发射中心分别位于 417 和 460 nm; 掺 $Ce_2(CO_3)_3$ 的发光中心分别位于 424 和 469 nm。波长为 325 nm 的激发光把电子从基态 $^2F_{5/2}$ 激发到激发态 $^2D_{5/2}$,然后经过无辐射跃迁到达 $^2D_{3/2}$ 态,最后从 $^2D_{3/2}$ 态经过辐射跃迁回到基态 $^2F_{5/2}$ 或亚稳态 $^2F_{7/2}$,在这个过程中辐射出 417、460 nm(样品 b)或者 424、469 nm(样品 c)的光。将图 7 中发射峰的中心波长 417、460 nm 以及 424、459 nm 取倒数相减,得到

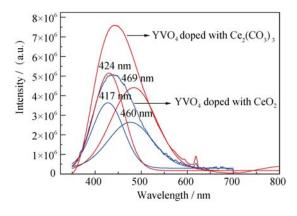


图 7 YVO₄: Ce³⁺晶体的发射光谱(λ_{ex} =325 nm) Fig. 7 Emission spectra of YVO₄: Ce³⁺ crystals under λ_{ex} of 325 nm

能级 $^2F_{7/2}$ 和 $^2F_{5/2}$ 的间距的实验值分别为 2242 和 2263 cm $^{-1}$,这与它的理论值 2250 cm $^{-1}$ 吻合得很好。样品 c 的发射峰中心(442 nm)相比样品 b(438 nm) 发生红移,在 YVO₄:Ce $^{3+}$ 晶体中,铈离子主要以低价(Ce $^{3+}$)形式存在,以高价(Ce $^{4+}$)形式存在的比例较小。三价 Ce $^{3+}$ 的电子构型是[Xe]4f 1 ,其中 4f 轨道被旋转轨道耦合劈裂成 $^2F_{5/2}$ 和 $^2F_{7/2}$ 。掺杂原料不同,Ce $^{3+}$ 浓度会有微小差别,相比掺 CeO₂ 样品,掺 Ce₂(CO₃)₃ 的样品的 Ce $^{3+}$ 浓度要稍微大些。由于晶体场效应 Ce $^{3+}$ 的 5d 轨道被劈裂,当更多的 Ce $^{3+}$ 代替半径较小的 Y $^{3+}$ 进主基质中时,晶体场作用增强,使得 5d 轨道存在较大的劈裂。因此,激发的 5d 轨道和 4f 基态之间的能量差减小引起红移,如图 8 所示。

比较 YVO₄和 YVO₄: Ce³⁺的发射光谱, Ce³⁺的掺入大幅提高了样品的蓝光发射性能。除了 Ce³⁺本身吸收激发能量产生蓝光发射外, YVO₄: Ce³⁺中的基质到激活剂 Ce³⁺间的能量传递起了很大作用。由于基质的 260~360 nm 激发带与 Ce³⁺的 5d"组态高能级特征激发有交迭, YVO₄基质和 Ce³⁺间可以产生很有效的能量传递,以致较低浓度的 Ce³⁺便可产生很强的发射。

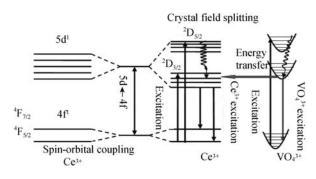


图 8 Ce³⁺和 VO₄³⁻之间的能量传递过程

Fig. 8 Schematic diagram of energy transfer process between $\mathrm{Ce^{3^{+}}}$ and $\mathrm{VO_4^{3^{-}}}$

根据过渡族元素的定域轨道分析方法,对 VO_4^{3-} ,每一个 O^2 -配位体的轨道为 sp^3 杂化,而 V^{5+} 的轨道为全空的 sd^3 轨道杂化, sd^3 杂化轨道中的 $3dx^2-y^2$ 和 $3dz^2$ 分别与 O^2 -配位体成 π 键轨道,它在稀土离子 (Ce^{3+}) 方向有最大的电子云密度。从结构上考虑,一个 VO_4^{3-} 的 π 轨道沿其 S_4 轴与两个不同的稀土离子重叠 $(V-O-Re^{3+}$ 夹角为 170° ,很接近直线),根据 Blasse 能量传递效率规律 $V-O-Re^{3+}$ 键角值越大,则基质到发光中心能量传递效率越高,进而导致荧光体的发光强度越高。当 Ce^{3+} 取代 Y^{3+} 时, Ce^{3+} 的 Sd 轨道与 VO_4^{3-} 的 π 轨道重叠, Ce^{3+} 和 VO_4^{3-} 间便可通过交换作用来传递能量,使 Ce^{3+} 被有效地激发, Ce^{3+} 和 VO_4^{3-} 之间的能量传递如图 8 所示。

根据图6中YVO₄和YVO₄:Ce³⁺的发射光谱,计算出其CIE坐标,并将计算出来的CIE坐标分别标在色域图中,如图9所示。325 nm紫外光激发下,三样品都呈现出蓝光发射。Ce³⁺的掺入提高了样品的发光强度,同时也改变了蓝光发射的色域坐标。其中C样品掺Ce₂(CO₃)₃的YVO₄:Ce³⁺样品的色坐标(0.1373, 0.078) 与商用BAM: Eu²⁺ (0.144, 0.072) 接近。可见,Ce³⁺的浓度直接影响蓝光发射的效果。

3 结论

利用提拉法生长了高质量的 YVO₄和 YVO₄:Ce³⁺晶体,其中 YVO₄:Ce³⁺晶体分别通过在 YVO₄ 中掺

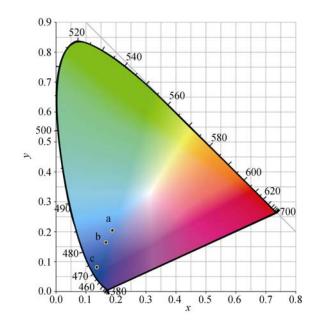


图 9 325 nm 紫外光激发下 YVO₄和 YVO₄: Ce³⁺ 晶体的 CIE 坐标

Fig. 9 CIE chromaticity coordinates for YVO_4 and YVO_4 : Ce^{3+} crystals excited by 325 nm UV light

入 Ce₂(CO₃)₃ 和 CeO₂ 获得。讨论了 YVO₄ 和 YVO₄:Ce³⁺晶体的发光性质。 XPS 测试表明 YVO₄:Ce³⁺晶体中 Ce 离子以 Ce³⁺和 Ce⁴⁺两种价态 形式存在。发射光谱显示 YVO4 和 YVO4: Ce3+在 325 nm 紫外光激发下都可以产生高亮度蓝色宽带 发射, 并以掺杂 Ce₂(CO₃)₃ 的 YVO₄: Ce³⁺发射强度 最高。YVO4 中蓝光发射应归属于 VO43-离子团中 ${}^{3}T_{2} \rightarrow {}^{1}A_{1}$ 和 ${}^{3}T_{1} \rightarrow {}^{1}A_{1}$ 跃迁; 而 YVO₄: Ce³⁺的蓝光发 射则来源于 Ce³⁺的 5d→4f 的跃迁。YVO₄中 VO₄³⁻ 的π轨道使得 VO₄3-和稀土 Ce³⁺的电子云有效地重 叠, 从而 VO43-和 Ce3+可通过交换作用有效传递能 量, 所以在 Ce³⁺浓度较低的样品中依然可以呈现 强度较强的蓝光发射。激发谱和发射谱表明 YVO4: Ce³⁺适于作UV-LED激发的蓝色发光材料。在325 nm 紫外光激发下, 掺 Ce₂(CO₃)₃ 的 YVO₄:Ce³⁺晶体色 坐标为(0.1373, 0.078), 与商用 BAM: Eu²⁺ (0.144, 0.072) 接近。可见优化 Ce³⁺浓度, YVO₄: Ce³⁺晶体 有望实现更好的蓝光发射。

参考文献:

- [1] LI PANLAI, WANG YING, GUO QINGLIN. Research progress in single host white light emitting phosphor for white LEDs. *Chinese Science Bulletin*, 2011, **56(7)**: 488–503.
- [2] WANG DELIU, FU RENLI, HE HONG, et al. Research and development of phosphors for white light emitting diode. Materials Review, 2007, 21(8): 111–115.
- [3] EKAMBARAM S, PATIL K C, MAAZA M. Synthesis of lamp phosphors: facile combustion approach. *Journal of Alloys and Compounds*, 2005, 393(1/2): 81–92.
- [4] ANKAM BHASKAR, HORNG-YICHANG, TSUN-HSU CHANG. Microwave annealing of YAG:Ce nanophosphors. *Materials Letters*, 2012, 78: 124–126.
- [5] JIA ZHENGGENG, JIN RUI. Degradation mechanism of blue phosphor. *Optoelectronic Technology*, 2000, **20(1):** 69–74.
- [6] ZHOU MEI-JIAO, ZHANG JIA-CHI, WANG YU-HUA. The degradation mechanisms of lamp used BaMgAl₁₀O₁₇: Eu²⁺, Mn²⁺ phosphor. *Acta Phys. Sin.*, 2012, 61(7): 074103–1–4.
- [7] 王贵超. 白光 LED 用蓝色荧光粉 BaMgAl₁₀O₁₇: Eu²⁺的制备及性能优化研究. 湖南: 湖南农业大学硕士论文, 2012.
- [8] ZENG QIHUA, ZHANG XINGUO, LIANG HONGBIN, et al. Progress of research on phosphors for white-light emitting diodes. Journal of the Chinese Rare Earth Society, 2011, 29(1): 8–17.
- [9] RIWOTZKI K, HAASE M. Wet-chemical synthesis of doped colloidal nanoparticles: YVO₄: Ln (Ln=Eu, Sm, Dy). *J. Phys. Chem. B*, 1998, 102(50): 10129–10135.
- [10] OSAWA S, KATSUMATA T, IYODA T, et al. Effects of composition on the optical properties of doped and nondoped GdVO₄. J. Crystal Growth, 1999, 198/199(1): 444–448.
- [11] BLASSE G. On the Eu³⁺ fluorescence of mixed metal oxides. IV. The photoluminescent efficiency of Eu³⁺-activated oxides. *J. Chem. Phys.*, 1966, **45**(7): 2356–2360.
- [12] VICTORY DEVI CH, GANGGAM PHAOMEI, YAIPHABA N, et

- al. Luminescence behavior of YVO₄: Dy³⁺ phosphors with enhanced photoluminescence on co-doping Bi³⁺ ions. *J. Alloys Compd.*, 2014, **583**: 259–266.
- [13] WANG YUHUA, ZUO YINYAN, GAO HUI. Luminescence properties of nanocrystalline YVO₄: Eu³⁺ under UV and VUV excitation. *Materials Research Bulletin*, 2006, 41(11): 2147–2153.
- [14] ZHOU Y H, LIN J. Morphology control and luminescence properties of YVO₄:Eu phosphors prepared by spray pyrolysis. *Optical Materials*, 2005, 27(8): 1426–1432.
- [15] ARNAUD HUIGNARD, VALE'RIE BUISSETTE, ANNE-CHRISTINE FRANVILLE, et al. Emission processes in YVO₄:Eu nanoparticles. J. Phys. Chem. B. 2003, 107(28): 6754–6759.
- [16] HUANG PING, CHEN DAQIN, WANG YUANSHENG. Host-sensitized multicolor tunable luminescence of lanthanide ion doped one-dimensional YVO₄ nano-crystals. *J. Alloys Compd.*, 2011, 509 (7): 3375–3381.
- [17] PARK W J, JUNG M K, YOON D H. Influence of Eu³⁺, Bi³⁺ co-doping content on photoluminescence of YVO₄ red phosphors induced by ultraviolet excitation. Sensors and Actuators B: Chemical, 2007, 126(1): 324–327.
- [18] WU KE, WANG LE, XU GUOTANG, et al. Hydrothermal method synthesis and characterization of YVO₄: Eu³⁺@YPO₄ core-shell ohosphor. *Journal of Inorganic Materials*, 2012, 27(7): 706–710.
- [19] LU F C, GUO S Q, YANG Z P, et al. Photoluminescence properties of Y₅Si₃O₁₂N: Ce³⁺ blue-emitting phosphors for white LED. *J. Alloys Compd.*, 2012, **521:** 77–82.
- [20] ZHANG NIUMIAO, GUO CHONGFENG, JING HENG, et al. Color tunable emission in Ce³⁺ and Tb³⁺ co-doped Ba₂Ln(BO₃)₂Cl (Ln=Gd and Y) phosphors for white light-emitting diodes. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2013, 116: 556–561.
- [21] YU RUIJIN, WANG JING, ZHANG MEI, *et al.* A new blue-emitting phosphor of Ce³⁺-activated CaLaGa₃S₆O for white-light-emitting diodes. *Chemical Physics Letters*, 2008, **453** (4): 197–201.
- [22] LV WENZHEN, GUO NING, JIA YONGCHAO, et al. A potential single-phased emission-tunable silicate phosphor Ca₃Si₂O₇: Ce³⁺, Eu²⁺ excited by ultraviolet light for white light emitting diodes. Optical Materials, 2013, 35(5): 1013–1018.
- [23] FENG H, REN R H, DING D Z, *et al.* Defect optical and scintillation properties of Lu₂Si₂O₇:Ce single crystal grown by floating zone method. *Journal of Inorganic Materials*, 2013, **28(8)**: 891–895.
- [24] WANG Y F, WANG S, RUAN Y F, *et al.* Photoluminescence properties of Ce and Eu co-doped YVO₄ crystals. *J. Alloys Compd.*, 2013, **551:** 262–266.
- [25] YANG ZHI-PING, WANG FENG-HE, GUO YING-NAN, et al. Optical properties of Eu²⁺-activated blue-emitting phosphor LiCaPO₄ under ultraviolet excitation. Chinese Journal of Luminescence, 2010, 31(2): 181–184.
- [26] XIN JUAN, YU YINGCHUN, LIU JIANJUN, *et al.* Synthesis of fluorescent YVO₄: Eu nano-particle and its application in developing fingerprint. *Chemical Research*, 2010, **21(2)**: 1–6.
- [27] ZHU YONGCHANG, TENG WEIFENG, LIU QUN, et al. XPS study of lithium-6 glass scintillator activated by Ce³⁺. *Journal of Functional Materials*, 2012, **43(11)**: 1392–1395.
- [28] LI LANLAN, LIN LIHUA, WU CHANGBAO, et al. First principles studies on structural properties and 4f-5d transitions of Cedoped YAlO₃ crystal. *Journal of Anhui Normal University (Natural Science)*, 2010, **36(3)**: 235–239.